# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-322169

(43) Date of publication of application:

12.11.1992

(51)Int.CI.

H02M 7/48 H02M 7/5387 H05B 41/24 // H02M 1/00

(21)Application number: 03-090695

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

LTD

(22)Date of filing:

22.04.1991

(72)Inventor: NIIHORI HIROSHI

SHIOMI TSUTOMU

#### (54) DISCHARGE LAMP LIGHTING APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To quickly detect a lamp voltage of a discharge lamp.



CONSTITUTION: One end of a discharge lamp DL is connected to a connecting point of switching elements Q1, Q2 via an inductor L1, the other end of the discharge lamp DL is connected to a connecting point of switching elements Q3, Q4 via an inductor L2 having an inductance value almost equal to that of the inductor L1, and a capacitor C0 is connected in parallel with the discharge lamp DL Moreover, a voltage detecting means (not illustrated) for detecting voltages VA, VB across the discharge lamp DL is also provided. Thereby, the voltage across the discharge lamp DL is not varied due to high frequency switching operation of the switching elements Q1 to Q4. Accordingly, an integration circuit for controlling voltage variation is no longer required and delay of detection by integration can be eliminated. As a result, a lamp voltage of the discharge

lamp DL can be detected quickly and ON OFF states of the first to fourth switching elements Q1 to Q4 can be controlled depending on the condition change of the discharge lamp DL.

# 対応なし、英沙

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-322169

(43)公開日 平成4年(1992)11月12日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所

H02M

E 8730-5H

7/5387

8730-5H

H 0 5 B 41/24

K: 7913-3K

// H02M 1/.00 8325-5H

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平3-90695

(71)出願人 000005832

松下電工株式会社

(22) 出願日

平成3年(1991)4月22日

大阪府門真市大字門真1048番地

(72)発明者 新堀 博市

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工

株式会社内

(72)発明者 塩見 務

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工

株式会社内

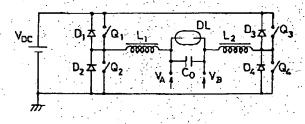
(74)代理人 弁理士 宮井 暎夫

### (54) 【発明の名称】 放電灯点灯装置

#### (57)【要約】

【目的】 放電ランプのランプ電圧を高速に検出する。 【構成】 スイッチング素子Qi Qz の接続点にイン ダクタL」を介して放電ランプDLの一端を接続し、ス イッチング素子Q。 Q. の接続点にインダクタLi と インダクタンス値の略等しいインダクタし、を介して放 電ランプDLの他端を接続し、放電ランプDLにコンデ ンサC。を並列接続する。また、放電ランプDLの両端 の電位VA, Vaを検出する電位検出手段(図示せず) を設ける。

【効果】 放電ランプDLの両端の電位がスイッチング 素子Q1~Q4の高周波のスイッチングによる変動がな くなるので、電圧変動抑制用の積分回路が不要となり、 積分による検出遅れがなくなる。この結果、放電ランプ DLのランプ電圧を高速に検出することができ、放電ラ ンプDLの状態変化に即して第1ないし第4のスイッチ ング素子Q1 ~Q. のオンオフを制御することができ



第1のスイッチング素子

第2のスイッチング案子

第8のスイッチング素子

第4のスイッチング索子

第1のインダクタ

第2のインダクタ

1

#### 【特許請求の範囲】

直流電源の正極と負極との間に第1およ 【贈求項1】 び第2のスイッチング素子をこの順に直列接続し、前記 直流電源の正極と負極との間に第3および第4のスイッ チング素子をこの順に直列接続し、前記第1および第2 のスイッチング素子の接続点に第1のインダクタを介し て放電ランプの一端を接続し、前記第3および第4のス イッチング素子の接続点に前記第1のインダクタとイン ダクタンス値の略等しい第2のインダクタを介して放電 ランプの他端を接続し、前記放電ランフにコンデンサを 並列接続し、前記放電ランプの両端の電位を検出する電 位検出手段を設け、前記第1および第4のスイッチング 素子のオンオフを繰り返させるとともに前記第2および 第3のスイッチング素子をオフに保持する第1の状態と 前記第2および第3のスイッチング素子のオンオフを繰 り返させるとともに前記第1および第4のスイッチング 素子をオフに保持する第2の状態とを交互に繰り返させ 前記電位検出手段の検出結果に基づいて前記第1,第 2. 第3および第4のスイッチング素子のオン期間とオ フ期間の長さを制御する制御手段を設けた放電灯点灯装

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、例えば高圧放電ランプをフルブリッジインバータで矩形波点灯させる放電灯点灯装置に関するものである。

[0002].

【従来の技術】図14に従来のこの種の放電灯点灯装置の回路図を示す。この放電灯点灯装置は、図14に示すように、直流電源Vbcの正極と負極との間に第1および第2のスイッチング素子Q1 , Q2 をこの順に直列接続するとともに、直流電源Vbcの正極と負極との間に第3 および第4のスイッチング素子Q2 , Q4 をこの順に直列接続し、第1, 第2, 第3および第4のスイッチング素子Q1 , Q2 , Q3 , Q4 に第1, 第2, 第3および第4のダイオードD1 , D2 , D4 をそれぞれ逆並列接続している。

【0003】そして、第1および第2のスイッチング素子Qx, Qx の接続点に放電ランプDLの一端を接続し、第3および第4のスイッチング素子Qx, Q4 の接続点にインダクタし。を介して放電ランプDLの他端を接続し、放電ランプDLにコンデンサCoを並列接続している。また、放電ランプDLの両端の電位Vx, Vx (その差電圧はランプ電圧となる)を検出する電位検出手段(図示せず)を設けるとともに、第1,第2,第3および第4のスイッチング素子Qx, Qx, Qx, Qx, のオンオフを制御する制御手段(図示せず)を設けている

 $[0\ 0\ 0\ 4]$  以上のような構成の放電灯点灯装置は、制 電位 $V_{\bullet}$  と電位 $V_{\bullet}$  の差がランプ電圧 $V_{\bullet 1}$  となるが、電御手段により、具体的には、第1 および第4 のスイッチ 50 位 $V_{\bullet}$  ,  $V_{\bullet}$  のそれぞれにスイッチング周波数でチョッ

ング素子Q1,Q4のオンオフを高い周波数で繰り返させるとともに第2および第3のスイッチング素子Q1,Q3をオフに保持する第1の状態と第2および第3のスイッチング素子Q1,Q3のオンオフを高い周波数で繰り返させるとともに第1および第4のスイッチング素子Q1,Q4をオフに保持する第2の状態とを低い周波数で交互に繰り返させる。

【0005】また、電位検出手段の検出結果に基づいて、第1、第2、第3および第4のスイッチング素子Q1、Q2、Q2、Q2のオン期間とオフ期間の長さを制御することにより、ランブ電圧もしくランブ電流を制御する。上記の放電灯点灯装置は、放電ランブDLの両端の電位V1、V1はそれぞれ図15(a)、(b)に示すようになる。図15において、SW1は第1および第4のスイッチング素子Q1、Q4のオンオフを高い周波数で繰り返させるとともに第2および第3のスイッチング素子Q2、Q2をオフに保持する第1の状態の期間である。

【0006】 Volはランプ電圧であり、電位 Voには、 期間 S Wo ではランプ電圧 Volが負極性に重量し、 期間 S Wo ではランプ電圧 Volが正極性に重量する。 上記に おいて、 放電ランプ D L の 両端の電位を検出する電位 検 出手段としては、 例えば図 16に示すような差動増幅器 D Ao が考えられ、 先の放電ランプ D L の 両端の電位 Volo を直流電源 Volo の負極側をグラウンドとして入力することで、 差動増幅器 D Ao の 出力電圧 Volo として 図 17に示すようなランプ電圧 Volo を検出することができる。 なお、図 17では、 期間 S Wo では ランプ電圧 Volo が正極性となり、 期間 S Wo では負極性となっている。

【0007】また、図16の差動増幅器DA。に代えて、図18に示すようなダイオードD11,抵抗R17およびコンデンサC。からなる検波回路DWを用いることで、簡易にランプ電圧 $V_{01}$ を検出することができる。つまり、この検波回路DWは、電位 $V_{01}$ を直流電源 $V_{01}$ の負極側をグラウンドとして、半波整流および積分する構成であり、抵抗 $R_{17}$ およびコンデンサ $C_{10}$ の時定数を、期間 $SW_{10}$ と期間 $SW_{10}$ の切換周期に比べて充分に大きく設定しており、その出力電圧 $V_{01}$ としては図19に示す電圧が得られる。なお、この電圧 $V_{01}$ のピーク値は $V_{10}$ に $V_{11}$ となる。ただし、直流電源電圧 $V_{01}$ は一定とする。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】図14の回路に図16の差動増幅器DA。を組み合わせた第1の従来例では、電位V』と電位V』の差がランプ電圧V。」となるが、電位V』、V』のそれぞれにスイッチング周波数でチョッ

プされた電源電圧が同相分として重量される。このような信号電位の差を計算するには、差動増幅器DA」が用いられる。しかし、差動増幅器DA」は、同相分を除去する能力が同相分の周波数が高くなるに従って低下する性質がある。そのため、差動増幅器DA」の出力に同相分が重量し、その除去のため、積分回路を付加する必要

【0009】また、図14の回路に図18の検波回路DWを組み合わせた第2の従来例では、半周期の電圧を積分回路により作っているため、切換周期に対して十分に 10長い時定数を有していなければならない。このように、ランプ電圧Vnの検出回路に積分回路を挿入する必要が生じる。しかし、積分回路の時定数が長いと、実際の放電ランプDLの状態に対して検出に時間遅れが発生するため、放電ランプDLの状態に応じた制御を行うことができないという問題があった。

【0010】したがって、この発明の目的は、放電ランプのランプ電圧を高速に検出することができる放電灯点 灯装置を提供することである。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】この発明の放電灯点灯装置は、図1に示すように、直流電源Vncの正極と負極との間に第1および第2のスイッチング素子Qn , Qn をこの順に直列接続するとともに、直流電源Vncの正極と負極との間に第3および第4のスイッチング素子Qn , Qn をこの順に直列接続している。そして、第1および第2のスイッチング素子Qn , Qn を徐続点に第1のインダクタLn を介して放電ランプDLの一端を接続し、第3および第4のスイッチング素子Qn , Qn の接続点に第1のインダクタLn とインダクタンス値の略等しい第2のインダクタLn を介して放電ランプDLの他端を接続し、放電ランプDLにコンデンサC。を並列接続している。

【0012】また、放電ランプDLの両端の電位 VA, Va を検出する電位検出手段(図示せず)を設け、第1 および第4のスイッチング素子Q1, Q4 のオンオフを繰り返させるとともに第2および第3のスイッチング素子Q1, Q3 のオンオフを繰り返させるとともに第1および第4のスイッチング素子Q1, Q4 をオフに保持する第2の状態とを交互に繰り返させ、電位検出手段の検出結果に基づいて第1, 第2, 第3および第4のスイッチング素子Q1, Q1, Q1, Q1, Q1のオン期間とオフ期間の長さを制御する制御手段を設けている。

 $\{0.0.1.3\}$   $D_1$   $\sim D_4$  はスイッチング素子 $Q_1$   $\sim Q_4$  に逆並列接続したダイオードである。なお、第1および第2のインダクタ $L_1$  ,  $L_2$  は鉄心が共通であっても、独立していても、どちらでもよい。

[0014]

【作用】この発明の構成によれば、放電ランプDLの両側にインダクタンス値の略等しい第1および第2のインダクタL」、Liを設けたため、第1ないし第4のスイッチング素子Qi~Qiの高周波のスイッチングによる放電ランプDLの両端の電位の変動がなくなる。したがって、電圧変動抑制用の積分回路が不要となり、積分による検出遅れがなくなる。この結果、放電ランプDLのランプ電圧を高速に検出することができ、放電ランプDLの状態変化に即して第1ないし第4のスイッチング素子Qi~Qiのオンオフを制御することができる。

# 【0015】 【実施例】

(第1の実施例) この発明の第1の実施例を図2ないし図4に基づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図2に示すように、放電ランプDLの一端を第1および第2のスイッチング素子Q1,Q2の接続点に第1のインダクタL1を介して接続し、放電ランプDLの他端を第3および第4のスイッチング素子Q3,Q4の接続点に第2のインダクタL2を介して接続している。第1および第2のインダクタL1,L1はインダクタンス値が降等しく設定され、その直列合成インダクタンス値が従来のインダクタし。と同じに設定される。

【0016】また、放電ランプDLの両端の電位 Va, VaはダイオードDa, Da および抵抗Ra からなる最大値検出回路M Xa で検出され、電位 Va, Va の最大値が出力電圧 Vas として出力される。この場合、放電ランプDLの両側にインダクタンス値の略等しい第1おいし第2のインダクタLa, La を設けたため、第1ないし第4のスイッチング素子Qa ~Qa の高周波のスイッチングはよる放電ランプDLの両端の電位 Va, Va の変動がなくなる。したがって、電圧変動抑制用の積分回路が不要となり、積分による検出遅れがなくなる。この結果、放電ランプDLのランプ電圧を高精度かつ高速に検出することができ、放電ランプDLの状態変化に即して第1ないし第4のスイッチング素子Qa, Qa, Qa, のオンオフを制御することができ、例えばランプ電圧, ランプ電流等の変動を抑制することができる。

【0017】しかも、回路構成は、ダイオードDs. D。および抵抗Riからなる最大値検出回路MXiを使用するだけであり、きわめて簡単な回路で電圧検出を行うことができる。また、図13のように、インパータIV(第1~第4のスイッチング素子Qi~Qiからなる)から放電ランプDLへ至る2本のケーブルが地絡事故を起こしても、両側のケーブルにインダクタLi, L2 が挿入されているので、このインダクタLi, L2 が種別され、スイッチング素子Qi~Qiが破壊すること

【0018】図3は図2の放電灯点灯装置における最大 の 値検出回路MX:の入出力電圧を示すもので、(a)は 5

電位 $V_{\lambda}$  を、(b)は電位 $V_{\lambda}$  を、(c)は電圧 $V_{0.5}$  を それぞれ示している。図 3 から明らかなように、電位 $V_{\lambda}$  は、期間 S  $W_{1}$  では( $V_{0.5}$  +  $V_{0.1}$ ) /2 となり、期間 S  $W_{1}$  では( $V_{0.5}$  -  $V_{0.1}$ ) /2 となり、期間 S  $W_{2}$  では( $V_{0.5}$  +  $V_{0.1}$ ) /2 となり、期間 S  $W_{2}$  では( $V_{0.5}$  +  $V_{0.1}$ ) /2 となる。したがって、最大値検出回路M  $X_{1}$  は、電位 $V_{1}$  、 $V_{2}$  の最大値を出力するので、常に( $V_{0.5}$  +  $V_{0.1}$ ) /2 となる。

【0019】図4はランプ電圧Volの変化に伴う電圧Volの変化を示す特性図であり、Voloは無負荷ランプ電圧である。

(第2の実施例) この発明の第2の実施例を図5および 図6に基づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図2における最大値検出回路MX1に代えて、ダイオードD, および抵抗R, よりなる最小値検出回路MI1を用いたもので、その他の構成は図2の放電灯点灯装置と同様である。

【0020】この実施例でも、前記第1の実施例と同様に、電圧変動抑制用の積分回路を要せずにランプ電圧を高精度かつ高速に検出することができる。したがって、放電ランプDLの状態変化に即して第1ないし第4のスイッチング素子Q1,Q2,Q1,Q1のオンオフを制御することができ、例えばランプ電圧、ランプ電流等の変動を抑制することができる。

【0021】しかも、回路構成は、ダイオード $D_{1}$ , $D_{2}$  および抵抗 $R_{2}$  からなる最小値検出回路M  $I_{1}$  を使用するだけであり、きわめて簡単に電圧検出を行うことができる。この実施例における最小値検出回路M  $I_{1}$  の出力電圧 $V_{0.4}$  は、電位 $V_{1}$  , $V_{2}$  の最小値を出力するので、常に( $V_{0.5}$   $-V_{0.1}$ ) /2 となる。

【0022】図6はランプ電圧Volの変化に伴う電圧Volの変化を示す特性図である。

(第3の実施例) この発明の第3の実施例を図7および 図8に基づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図2 の最大値検出回路MX,に代えて、差動増幅器DA,を 用いたもので、その他の構成は図2の放電灯点灯装置と 同様である。

【0023】この実施例でも、放電ランプDLの両側にインダクタンス値の略等しい第1および第2のインダクタL1、L1を設けたため、第1ないし第4のスイッチング素子Q1、Q1、Q1、Q1の高周波のスイッチングによる放電ランプDLの両端の電位V1、V1の変動がなくなる。したがって、第1の従来例のように、同相成分除去機能の高い差動増幅器を必要とせずに、あるいは積分回路を必要とせずに高精度かつ高速にに電圧検出を行うことができる。

【0024】また、放電ランプDLへ至る配線をインパータIVから引き出してもコモンモードノイズの発生が少ない。その他の効果は前記各実施例と同様である。

(第4の実施例) この発明の第4の実施例を図9に基づ 50

いて説明する。この放電灯点灯装置は、放電ランプDLの両端の電位VA, Vaを図7のように直接差動増幅器DAIに加えるのではなく、それぞれ抵抗R。およびコンデンサC1よりなる平均値回路と、抵抗R。およびコンデンサC2よりなる平均値回路とで、電位VA, Vaの平均値VA, Vaを求めた後、この差動増幅器DA2へ入力している。この場合、抵抗R。およびコンデンサC1の時定数ならびに抵抗R。およびコンデンサC1の時定数は、それぞれ期間SW1, SW2の切換周期にくらべて十分に大きく設定している。その他は図2と同様である。

【0025】以上のような構成では、電位 $V_A$ の平均値 $V_A$ /および電位 $V_B$ の平均値 $V_B$ /が両者ともに $V_B$ 6/2となるので、通常は差動増幅器 $DA_B$ の出力電圧 $V_B$ 6は零である。しかし、図13に示すように、インバータ1Vから放電ランプDLへ向かう電源線の1X本が地絡した場合、 $V_A$ / $=V_B$ / $=V_B$ 6/2ではなくなるので、電圧 $V_B$ 6には何らかの電圧が出力される。これにより、インバータ1V00異常を検出することができる。

【0026】その他の構成効果は先の従来例と同様である。

(第5の実施例) この発明の第5の実施例を図10および図11に基づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図2の最大値回路MX1に代えて、抵抗減衰回路を含む最大値回路MX2を用いたもので、その他の構成は図2と同様である。

【0027】この最大値回路MX: は、分圧抵抗Rs, Rs, Rr, Rs とトランジスタQs, Qs, Qr と、負荷抵抗Rs, Rioとからなり、分圧抵抗Rs, Rr は抵抗値が等しく、分圧抵抗Rs, Rs は抵抗値が等しい。この最大値回路MX: は、電位Vx を分圧抵抗Rs, Rs で分圧し、電位Vs を分圧抵抗Rr, Rsで分圧し、電流増幅を兼ねるNPN型のトランジスタQs, Qs で両分圧電圧の最大値を選択し、トランジスタQs, Qs で両分圧電圧の最大値を選択し、トランジスタQr のエミッタフォロワを通して出力電圧Vorを取り出している。なお、Vccは制御電源電圧で、Vor≦Vccである。

[0028] 上記のように構成するのは以下のような理由があるからである。一般に、検出した電圧を使用する制御回路は、インパータ回路に比べてかなり低い電圧を使用するため、電位 Va, Va をそのまま検出するのではなく、滅衰させて使用するのが普通である。滅衰器を挿入して最大値を出力するものとして、図11のように、図2の最大値回路 MX, に単に分圧抵抗 Ra, Ra, Rr, Ra を付加しただけの最大値回路 MX, が考えられるが、この回路では、負荷抵抗 Ra の影響で、滅衰率 Rz / (R1 + Rz) を正確に維持することができない。

【0029】そこで、図10に示した回路のように、ダ

イオードD。, D10に代えて、電流増幅を兼ねたNPN 型のトランジスタQs,Qoを使用して構成し、減衰率 を負荷抵抗R<sub>1</sub> の影響を受けずに正確に維持するととも に、トランシスタQs , Qeの反対導電型のPNP型ト ランジスタQ<sup>。</sup>および負荷抵抗Rioからなるエミッタフ ォロワ回路を設けて、トランジスタQs , Qe の温度特 性を補償するようにしている。

[0030] この実施例では、放電ランプDLの両端の 電位Vi, Vi を滅衰させた状態で最大値を検出するこ とができ、しかも滅衰率を正確に維持することができる。10 とともに、温度変化に対する変動も無くすることができ る。その他の効果は第1の実施例と同様である。

(第6の実施例) この発明の第6の実施例を図12に基 づいて説明する。この放電灯点灯装置は、図5の最小値 回路M I に代えて、抵抗減衰回路を含む最大値回路M 12 を用いたもので、その他の構成は図ると国際であ

A., MIS, MILCTULLAND WE , WE 負荷抵抗Ris; Risとからなり、砂な血流水は、水はは 抵抗値が等しく、分圧抵抗Riz、Ricは抵抗値が等し い。この最小値回路MI。は、電位V、を分圧抵抗 R11, R12で分圧し、電位V1を分圧抵抗R13, R14で 分圧し、後日

タQ,,Q。と反対導電型のNPN型のトランジスタQ 10のエミッタフォロワを通して出力電圧 Voaを取り出し ている。なお、Vccは制御電源電圧で、Vos≦Vccであ

【0032】この最小値回路MI2は、電流増幅を兼ね たNPN型のトランジスタQs , Qs を使用して構成 し、減衰率を負荷抵抗R,の影響を受けずに正確に維持 するとともに、トランジスタQs , Qs の反対導電型の PNP型トランジスタQ7 および負荷抵抗R10からなる エミッタフォロワ回路を設けて、トランジスタQ。, Q 。の温度特性を補償するようにしている。

【0033】この実施例では、放電ランプDLの両端の 電位V<sub>k</sub>, V<sub>k</sub>を減衰させた状態で最小値を検出するこ とができ、しかも減衰率を正確に維持することができる とともに、温度変化に対する変動も無くすることができ 40 る。なお、上記各実施例のインダクタレ1, し1 は、同 一鉄心に巻線を巻回したものでも、また別々の鉄心に巻 回したものでも、どちらでもよい。

# [0034]

【発明の効果】この発明の放電灯点灯装置によれば、放 電ランプの両側にインダクタンス値の略等しい第1およ び第2のインダクタを設けたため、第1ないし第4のス イッチング素子の高周波のスイッチングによる放電ラン ブの両端の電位の変動をなくすことができる。したがっ て、電圧変動抑制用の積分回路が不要となり、積分によ 50  $L_1$  第1のインダクタ

る検出遅れがなくなる。この結果、放電ランプのランプ 電圧を高速に検出することができ、放電ランプの状態変 化に即して第1ないし第4のスイッチング素子のオンオ フを制御することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の放電灯点灯装置の構成を示す回路図

【図2】この発明の第1の実施例の放電灯点灯装置の回 路図である。

【図3】図2の各部のタイムチャートである。

【図4】図2の回路におけるランプ電圧 Vilの変化に対 する電圧Vo,の変化を示す特性図である。

[図 5] この発明の第2の実施例の放電灯点灯装置の要 部の構成を示す回路図である。

【図6】図5の回路におけるランプ電圧V11の変化に対 する悪性Vosの変化を示す特性図である。

[図7] この発明の第3の実施例の放電灯点灯装置の要 ※窓図である。

INIO PRO TO回路の出力電圧のタイムチャートであ

[図9] この発明の第4の実施例の放電灯点灯装置の要 部の構成を示す回路図である。

【図10】この発明の第5の実施例の放電灯点灯装置の 要部の構成を示す回路図である。

【図11】参考となる最大値回路の回路図である。

【図12】この発明の第6の実施例の放電灯点灯装置の 要部の構成を示す回路図である。

【図13】放電灯点灯装置の地絡の様子を示す概略図で 

【図14】放電灯点灯装置の従来例を示す回路図であ

【図15】図14の回路の各部のタイムチャートであ

【図16】放電ランプの両端電圧を検出する部分の回路 図である。

【図17】図16の回路の出力電圧のタイムチャートで

【図18】放電ランプの両端電圧を検出する部分の回路 図である。

【図19】図18の回路の出力電圧のタイムチャートで ある。

#### 【符号の説明】

Voc. 直流電源

第1のスイッチング素子  $Q_1$ 

Q: 第2のスイッチング素子

第3のスイッチング案子

Q₄ 第4のスイッチング案子

DL 放電ランプ

コンデンサ

# L. 第2のインダクタ

